

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【公開番号】特開2006-45021(P2006-45021A)

【公開日】平成18年2月16日(2006.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2006-007

【出願番号】特願2004-230529(P2004-230529)

【国際特許分類】

C 3 0 B	29/22	(2006.01)
B 0 1 J	23/18	(2006.01)
B 0 1 J	35/02	(2006.01)
B 8 2 B	1/00	(2006.01)
C 3 0 B	23/08	(2006.01)
C 3 0 B	29/30	(2006.01)
C 3 0 B	29/32	(2006.01)

【F I】

C 3 0 B	29/22	D
B 0 1 J	23/18	M
B 0 1 J	35/02	J
B 8 2 B	1/00	
C 3 0 B	23/08	Z
C 3 0 B	29/30	A
C 3 0 B	29/30	B
C 3 0 B	29/32	A

【手続補正書】

【提出日】平成19年6月1日(2007.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項8】

気相成長法において、所定の圧力の酸素雰囲気中で、所定の単結晶基板上に所定の基板温度で $\text{VO}_x$ （但し、 $1 < x < 2.5$ ）からなるフラックス層を堆積し、このフラックス層上に所定の基板温度で組成式 $(\text{Bi}_2\text{O}_2)_A(\text{m}-1)\text{Bi}_m\text{O}_{3m+1}$ （但し、AはSr, Ba、Ca又はBi、BはTi, Ta又はNb、m=1）で表される物質を堆積することを特徴とする、Bi層状化合物ナノプレート配列体の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項9】

気相成長法において、所定の圧力の酸素雰囲気中で、所定の単結晶基板上に所定の基板温度で $\text{VO}_x$ （但し、 $1 < x < 2.5$ ）からなるフラックス層を堆積し、このフラックス層上に所定の基板温度で $\text{Bi}_4\text{Ti}_3\text{O}_{12}$ を堆積することを特徴とする、Bi層状化合物ナノプレート配列体の製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 0】

前記単結晶基板は、 $SrTiO_3$  単結晶基板、 $Nb$  ドープ  $SrTiO_3$  単結晶基板、 $LaAlO_3$  単結晶基板、 $(LaAlO_3)_{0.3} (Sr_2AlTaO_6)_{0.7}$  単結晶基板、 $Si$  単結晶基板、 $NdGaO_3$  単結晶基板、 $YSZ$  単結晶基板、 $Al_2O_3$  単結晶基板、 $LaSrAlO_4$  単結晶基板又は $LaSrGaO_4$  単結晶基板であることを特徴とする、請求項 8 又は 9 に記載の  $Bi$  層状化合物ナノプレート配列体の製造方法。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 1】

前記単結晶基板は、 $SrTiO_3$  単結晶基板、 $LaAlO_3$  単結晶基板、 $(LaAlO_3)_{0.3} (Sr_2AlTaO_6)_{0.7}$  単結晶基板、 $Si$  単結晶基板、 $NdGaO_3$  単結晶基板、 $YSZ$  単結晶基板、 $Al_2O_3$  単結晶基板、 $LaSrAlO_4$  単結晶基板、 $MgO$  単結晶基板及び $LaSrGaO_4$  単結晶基板からなるグループの内から選択した一つの単結晶基板であり、この何れかの単結晶基板上に、 $Pr$ 、 $Ir$ 、 $IrO_2$ 、 $RuO_2$ 、 $La_{0.5}Sr_{0.5}CoO_3$ 、 $LaNiO_3$  及び $SrRuO_3$  からなるグループの内から選択した一つの物質の薄膜を堆積したことを特徴とする、請求項 8 又は 9 に記載の  $Bi$  層状化合物ナノプレート配列体の製造方法。